

SF 二进制可调容值单层芯片瓷介电容器

1 产品特点

◆ 单层芯片瓷介电容器体积小、精度高、结构坚固、性能稳定。

◆ 表面采用金电极，适合金丝、金带等微组装工艺。

◆ 一只产品上有多个电容且容值按照二进制递增，方便调谐、节约空间。



2 产品应用

广泛应用于光通信、无线通信等电子设备中，在高频、微波电路中起隔直、旁路、滤波、耦合、调谐、匹配等作用。

3 订货示例

SF	3	25	CG	2A	0R2M	C	C	01
产品型号	电极结构	外形尺寸代码	温度特性 (系数)	额定电压	标称电容量及容差	电极材料	包装形式	产品设计
表 1	表 2	表 3	表 4	表 5	表 6、7	表 8	表 9	表 10

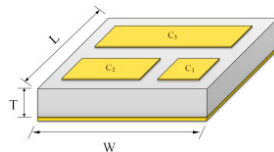
表 1 产品型号	表 2 电极结构	外形图
SF：二进制可调容值单层芯片瓷介电容器	3：3 电极 4：4 电极	

表 3 外形尺寸代码 (mm)					
外形尺寸代码	标称电容量及容差	电容个数	L、W	T	空边宽度 B
15	R08M	3	0.381 ± 0.254	0.102 ^{+0.254} _{-0.022}	0.051 ± 0.051
15	0R1M	3	0.381 ± 0.254	0.152 ^{+0.254} _{-0.072}	
20	0R1M	3	0.508 ± 0.254	0.152 ^{+0.254} _{-0.072}	
20	0R2M	3	0.508 ± 0.254	0.152 ^{+0.254} _{-0.072}	
25	R08M	3	0.635 ± 0.254	0.102 ^{+0.254} _{-0.022}	
25	0R2M	3	0.635 ± 0.254	0.152 ^{+0.254} _{-0.072}	
25	0R4M	3	0.635 ± 0.254	0.152 ^{+0.254} _{-0.072}	
35	0R1M	3	0.889 ± 0.254	0.152 ^{+0.254} _{-0.072}	
35	0R4M	3	0.889 ± 0.254	0.152 ^{+0.254} _{-0.072}	
40	0R5M	4	1.016 ± 0.254	0.191 ^{+0.254} _{-0.111}	

表 4 温度特性 (系数)	工作温度范围	表 5 额定电压	
AG、CG、UK VL、KL、DM	-55℃ ~ 125℃	1H	50V
		2A	100V

表 6 标称电容量	表 7 容差
采用三位标法，前两位代表电容量的有效值，第三位代表有效值后 0 的个数，单位为 pF，例如：101=100pF；10pF 以下的，用 R 表示小数点，例如：3R9=3.9pF。	M：±20%

SF 二进制可调容值单层芯片瓷介电容器

表 8 电极材料		表 9 包装形式	表 10 产品设计	
P：TiW/Au		C：华夫盒包装 E：蓝膜包装，7.87 寸蓝膜， 无扩晶环 F：蓝膜包装，带 6 寸扩晶环	产品设计代码：默认空缺；	
T：TiW/Ni/Au			当用户特殊要求或产品设计改进等需对同一型号规格产	
C：NiCr/Au			品加以区分时，在产品命名规则最后增加代码，采用两	
S：特殊电极			位数字表示，从“01”开始按顺序排行。	
4 SF 系列二进制 1 类瓷电容量范围				
外形尺寸代码	额定电压（V）	标称电容量及容差	电容个数	电容容值分布（pF）
15	50	R08M	3	0.08，0.15，0.3
15	100	0R1M	3	0.1，0.2，0.4
20	100	0R1M	3	0.1，0.2，0.4
20	100	0R2M	3	0.2，0.4，0.8
25	50	R08M	3	0.08，0.15，0.3
25	100	R02M	3	0.2，0.4，0.8
25	100	0R4M	3	0.4，0.8，1.6
35	100	0R1M	3	0.1，0.2，0.4
35	100	0R4M	3	0.4，0.8，1.6
40	100	0R5M	4	0.5，1，2，4